

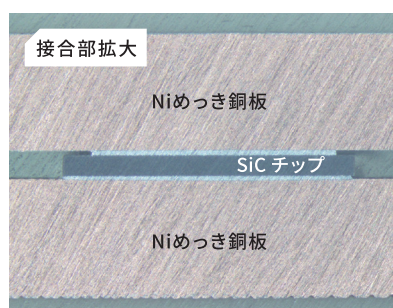
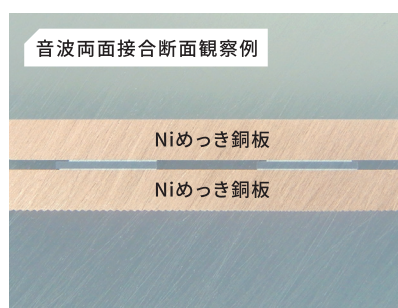
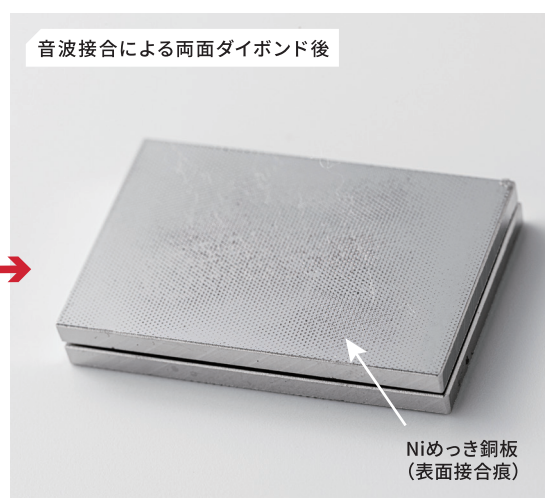
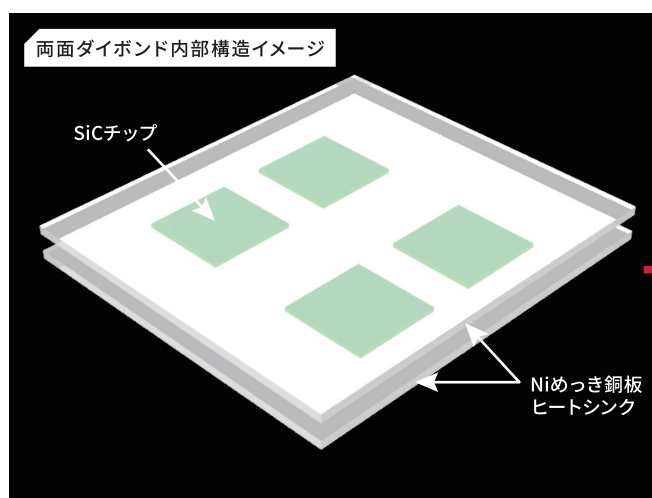


Patented

Application

Bonding ボンディング

ヒートシンクに挟まれたパワー半導体SiCチップの音波接合による両面ダイボンド



4個のSiCが
2枚のNiめっき銅板の間に
両面ダイボンドされた
[SiCパッケージ]

Point ここがポイント

- 異種材料を重ねた[3DB&DMB]接合
- SiCチップとNiめっき銅ヒートシンク間の接合
- 音エネルギーのみで接合 接着剤や金属ペーストの加熱不要
- ヒートショックテストクリア(-50~600℃)
- 大気中常温接合
- 接合のエネルギー源は電気とエアーのみ
- デスクトップ接合

Product used 使用する装置

- 15MZs



AP-J-0097A4-2021112201